



## キーワード解説

### 酸化ストレス

体内の酸化反応によって起こる生体に有害な作用のこと。体内では、代謝等によって酸素から、種々の活性酸素が生成する。その中でヒドロキシルラジカル(OHラジカル)が最も酸化力が強く、DNA、RNA、脂質等が酸化され種々の疾患の大きな原因となる。

### ミストCVD

CVD(Chemical Vapor Deposition:化学気相成長法)は、目的成分を含む原料ガスにエネルギーを加えて化学反応を起こし、基板上に薄膜を堆積する方法。これに対してミストCVDは、霧状にした前駆体溶液を導入して基板上で加熱し、化学反応を起こして薄膜を形成する方法である。ガス化が難しい成分でも溶液にできれば原料にできるため、広範な材料の成膜が可能である。

### 無電解金めっき

通常の電気めっきと異なり、電流を使用せずに目的基板上に金を成膜するめっき方法。イオン化傾向の差を利用して卑金属上に金を析出させる置換金めっきと、還元剤を用いて金上に金を厚付けする自己触媒型金めっきがある。コストや性能面からシアン含有タイプが主流だが、環境に配慮したノーシアンタイプも増えている。

### Oxide semiconductor(酸化物半導体)

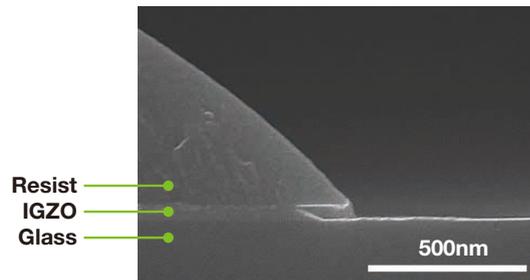
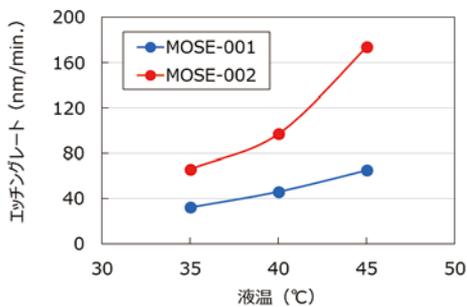
主に金属酸化物からなる半導体で、多くが広いバンドギャップを有し、可視光を透過する。代表的なITO(Indium tin oxide:酸化インジウムスズ)は透明電極としてLCDやタッチパネルなどに応用されている。IGZO(Indium, Gallium, Zincから構成される酸化物)はTFT(Thin Film Transistor:薄膜トランジスタ)を小型化できるため、各社のディスプレイで採用されている。

## 金属酸化物半導体エッチング液 MOSEシリーズ

サイドエッチング量が小さく、IGZO膜の微細加工が可能です。

酸性の有機酸系組成で、制御しやすい低速エッチングレートを実現しました。

アモルファスITOエッチング液として使用することもできます。



製品名	使用温度	処理方法
MOSE-001 (低速タイプ) MOSE-002 (高速タイプ)	30~50°C	ディップ、スプレー両用

※無断転載および複製を禁じます。